К1128КТ5,6 – МОСТОВОЙ ДРАЙВЕР ОДНОФАЗНОГО ДВИГАТЕЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА

Настоящая спецификация распространяется на микросхемы интегральные К1128КТ5,6 бескорпусном исполнении неразделенные в пластинах, предназначенные для работы в качестве мостового драйвера однофазного двигателя вентилятора в изделиях гражданского применения

1. Назначение

1.1. Особенности

Возможность работы от напряжений 5 и 12 В

Встроенная схема восстановления позволяет использовать защитный диод в обратном включении

Встроенный усилитель сигнала с датчика Холла с гистерезисом (поддержка датчиков Холла с дифференциальным выходом)

Встроенная защита от блокировки и схема автоматического восстановления вращения

Выход определения частоты вращения (FG)

Вывод отключения датчика Холла и вывод старт/стоп (ST) позволяет уменьшить ток потребления в дежурном режиме

Встроенная схема температурной защиты

1.2. Структурная схема ИС К1128КТ5,6

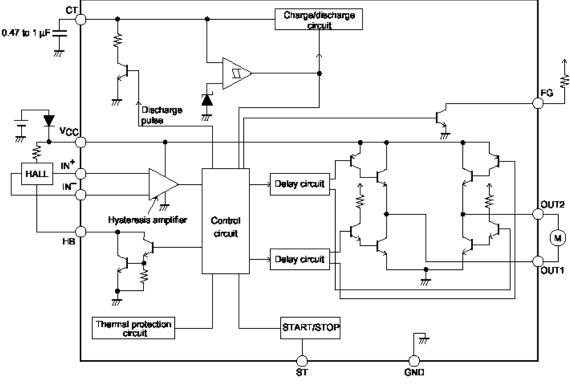


Рис. 1

1.3. Типовая схема применения

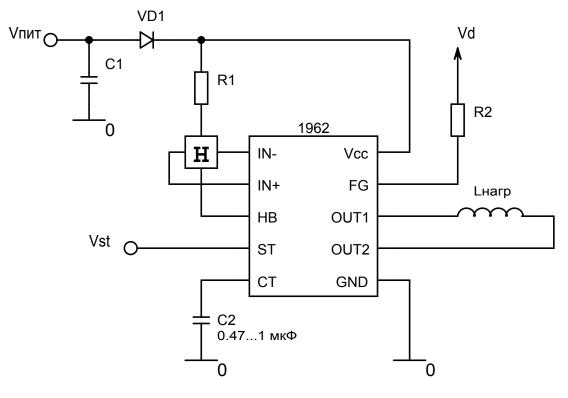


Рис. 2

2. Требования к конструкции

2.1. Физические характеристики пластин

Диаметр пластин – 100 мм Толщина пластины – 300 $^{+30}_{-30}$ мкм Размер кристалла – 2.35 мм × 1.8 мм Ширина скрайберной дорожки – 120 мкм Защита – полиимид Металлизация обратной стороны пластины – Ti-Ni-Ag Количество физических кристаллов на пластине не менее 1500



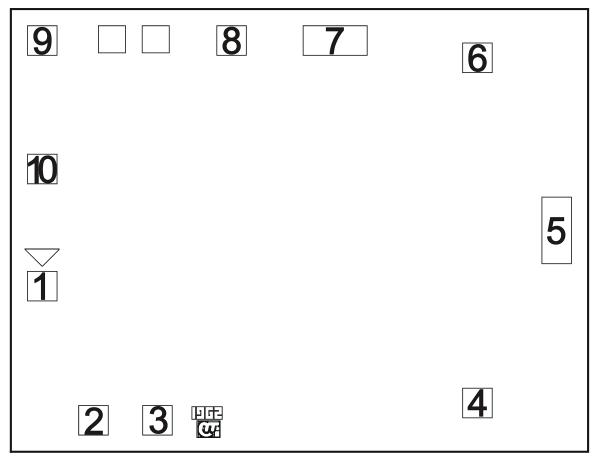


Рис. 3

Номер	Номер	Наименование	Размер	Координа	аты (мкм)
площадки	вывода	площадки	площадки	Х	Y
			(мкм × мкм)		
1	1	IN –	120×120	70	614
2	2	IN +	120×120	278	70
3	3	СТ	120×120	538	70
4	4	OUT1	120×120	1838	140
5	5	GND	120×270	2160	765
6	6	OUT2	120×120	1838	1540
7	7	VCC	260×120	1190	1610
8	8	ST	120 × 120	839	1610
9	9	HB	120×120	70	1610
10	10	FG	120×120	70	1089

2.3. Расположение контактных площадок

Таблица 1

ПРИМЕЧАНИЕ: Х и У - координаты левого нижнего угла площадки относительно лево-

го нижнего угла кристалла (от середины скрайберной дорожки).

3. Требования к электрическим параметрам и режимам эксплуатации.

3.1. Диапазон рабочих температур окружающей среды минус 30...+85 °С

3.2. Электрические параметры при Та=25°С, Vcc=12 В если не указано иное

Таблица 2

Параметр	Обозн.	Режимы	31	начен	ие	Ед.
Параметр	0003н.	гсжимы	МИН.	тип.	макс.	ИЗМ.
Ток потребления	Icc	В рабочем режиме (CT=[L],		6.5	9.0	мА
		ST=[L]), VCC=5 B				
		В рабочем режиме (CT=[L],		7.2	10	
		ST=[L]), VCC=12 B				
		В режиме блокировки		2.1	3.0	
		(CT=[H], ST=[L]), VCC=5 B				
		В режиме блокировки		2.4	3.5	
		(CT=[H], ST=[L]),				
		VCC=12 B				
		В дежурном режиме		110	150	мкА
		(ST=[H]), VCC=5 B				-
		В дежурном режиме		250	350	
	.	(ST=[H]), VCC=12 B				
Ток заряда конденсатора	Ict1	VCC=5 B	1.4	2.7	4	мкА
		VCC=12 B	1.8	3.1	4.6	
Ток разряда конденсатора	Ict2	VCC=5 B	0.21	0.43	0.65	мкА
	_	VCC=12 B	0.27	0.51	0.75	
Отношение токов заряда/	RCT	(Rct=Ict1/Ict2)	4.0	6.0	8.0	
/разряда конденсатора					• • •	-
Пороговое напряжение за-	Vct1	VCC=5 B	2.45	2.7	2.95	В
ряда по выводу СТ		VCC=12 B	2.6	2.85	3.1	
Пороговое напряжение раз-	Vct2	VCC=5 B	1.5	1.75	2.0	В
ряда по выводу СТ		VCC=12 B	1.6	1.85	2.1	
Выходное напряжение низ-	Vol	Іо=200 мА		0.22	0.3	В
кого уровня		Іо=350 мА		0.5	0.6	
Выходное напряжение вы-	Voh	Іо=200 мА	10.9	11.1		В
сокого уровня		Іо=350 мА	10.7	11.0		
Чувствительность по входу	Vhn			10	15	мВ
датчика Холла ¹						
Выходное напряжение низ-	VFG	IFG=5 MA		0.1	0.3	В
кого уровня по выводу FG						
Ток утечки по выводу FG	IFGL	V _{FG} =15 B			15	мкА
Выходное напряжение низ-	VHBL	Інв=5 мА		1.0	1.3	В
кого уровня по выводу НВ						
Входной ток по выводу ST	Ist	Vst=5B		75	100	мкА

ПРИМЕЧАНИЯ: 1. Чувствительность по входу датчика Холла – минимальное значение дифференциального входного сигнала, приводящее к переключению выходов

2. Нормы и режимы разбраковки на МЗУ, а также схемы измерения параметров приводятся в документе «К1128КТ5,6 Схема проведения разбраковки на МЗУ»

3.3. Электрические параметры в диапазоне рабочих температур окружающей среды, при Vcc=12 В

Таблица 3

Параметр	Обозначение	Режимы	Значение	Единица изм.
Максимальный ток по- требления в рабочем ре- жиме	Icc max	(CT=[L], ST=[L])	15	мА
Максимальное выходное напряжение низкого уровня	Vol max	Іо=200 мА	0.45	В
Минимальное выходное напряжение высокого уровня	Vон min	Іо=200 мА	10.75	В
Максимальное выходное напряжение низкого уров- ня по выводу FG	VFG max	IFG=5 MA	0.45	В
Максимальный ток утечки по выводу FG	Ifgl max	VFG=15 B	50	мкА
Максимальное выходное напряжение низкого уров- ня по выводу НВ	VHBL max	Інв=5 мА	1.5	В
Максимальный входной ток по выводу ST	Ist max	V _{ST} =5 B	300	мкА

3.4. Таблица истинности в диапазоне рабочих температур окружающей среды

Таблица 4

ST	IN–	IN+	СТ	OUT1	OUT2	FG	HB	Режим
Н	_	_	_	выкл.	выкл.	выкл.	выкл.	Ждущий
	Н	L	т	Н	L	Н	т	Dramanua
L	L	Н	L	L	Н	L		Вращение
	_	_	Н	выкл.	выкл.	_	L	Блокировки

ПРИМЕЧАНИЕ:

Н – высокий уровень L – низкий уровень

3.5. Предельные режимы в диапазоне рабочих температур окружающей среды

Параметр	Обозначение	Значение	Единица изм.
Максимальное напряжение питания	Vcc max	17	В
Максимальный выходной ток	Iout max	0.5	Α
Максимальное выходное выдерживаемое напря-	Vout max	15	В
жение			
Максимальное выходное выдерживаемое напря-	VFG max	17	В
жение по выводу FG			
Максимальный выходной ток по выводу FG	IFG max	5	мА
Максимальный выходной ток по выводу НВ	Інв тах	10	мА
Максимальное входное напряжение по выводу ST	Vst max	15	В

3.6. Предельно допустимые режимы в диапазоне рабочих температур окружающей среды

Параметр	Обозначение	Значение	Единица
парамотр	Обозначение Значение		ИЗМ.
Напряжение питания	Vcc	3.815	В
Напряжение высокого уровня по входу	STH	314	В
ST			
Напряжение низкого уровня по входу ST	STL	-0.3+0.4	В
Диапазон напряжений синфазного сигна-	VICM	0.2Vcc -1.5	В
ла на входе с датчика Холла			
Выходной ток	Iout	0350	мА

Таблица 6

4. Контроль качества

4.1. Правила приемки

4.1.1. Приемка микросхем по электропараметрам при приемо-сдаточных испытаниях осуществляется СКК предприятия изготовителя в составе технологического процесса изготовления микросхем по нормам и режимам в соответствии с «К1128КТ5,6 Схема проведения разбраковки на МЗУ» по планам контроля, установленным в ГОСТ 18725-83.

4.1.2. Приемка пластин по внешнему виду СКК осуществляет в соответствии с «Описанием образцов внешнего вида пластины» по планам контроля, установленным в ТД.

4.1.3. Испытания по группам П1-П2 проводят один раз в три месяца. Испытания проводятся в условном корпусе. Сборка микросхем в условный корпус проводится в соответствии с приложением А.

4.1.4. Нормы и режимы измерения параметров для всех видов испытаний приведены в табл. 3. Состав параметров по каждому виду испытаний приведен в табл. 7.

4.1.5. Испытания на безотказность проводят на микросхемах, распаянных по схеме приведенной на рис. 11. До и после испытаний измеряются параметры приведенные в табл. 3. В процессе испытания контролируется форма импульсов (рис. 12) и остаточные напряжения на выходах микросхемы. Остаточные напряжения нижних ключей должны быть не менее 0.2 В, верхних ключей – не менее 0.8 В.

4.1.6. Продолжительность испытаний на безотказность в составе квалификационных испытаний – 500 часов, в составе периодических испытаний – 100 часов.

Таблица 7

Группа	Вид и последователь-	Измеряем	ые параметри	ы, режимы	Метод по	Объем
испы-	ность испытания	перед ис-	в процессе	после ис-	OCT 11	вы-
тания		пытанием	испытания	пытания	073.013	борки
П-1	Испытания на безот-	Парамет-	Контроль	Парамет-	700-1	20 шт
	казность.	ры табл. 3	выходных	ры табл. 3		
			импульсов			
П-2	Испытания на воздей-	Парамет-	Парамет-	Парамет-	203-1	10 шт
	ствие пониженной ра-	ры табл. 3	ры табл. 3	ры табл. 3		
	бочей температуры					
	среды.					
	Испытания на воздей-	Парамет-	Парамет-	Парамет-	201-1.1	
	ствие повышенной ра-	ры табл. 3	ры табл. 3	ры табл. 3		
	бочей температуры					
	среды.					

4.2. Схемы измерения параметров

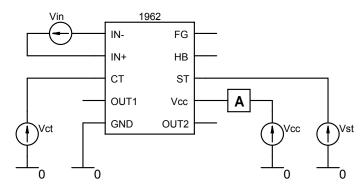


Рис. 4. Схема измерения параметров «Ток потребления»

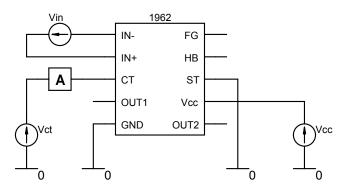


Рис. 5. Схема измерения параметров «Ток заряда/разряда конденсатора»

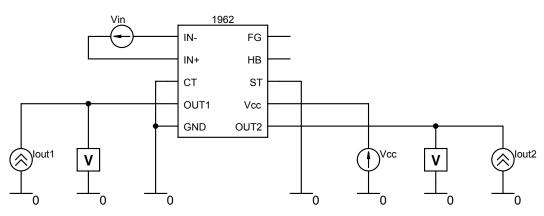


Рис. 6. Схема измерения параметров «Выходные напряжения»

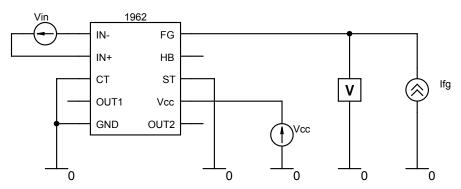


Рис. 7. Схема измерения параметра «Выходное напряжение низкого уровня по выводу FG»

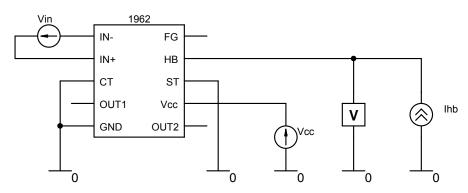


Рис. 8. Схема измерения параметра «Выходное напряжение низкого уровня по выводу НВ»

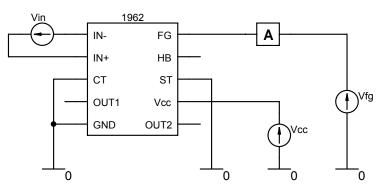


Рис. 9. Схема измерения параметра «Ток утечки по выводу FG»

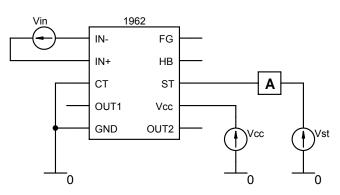
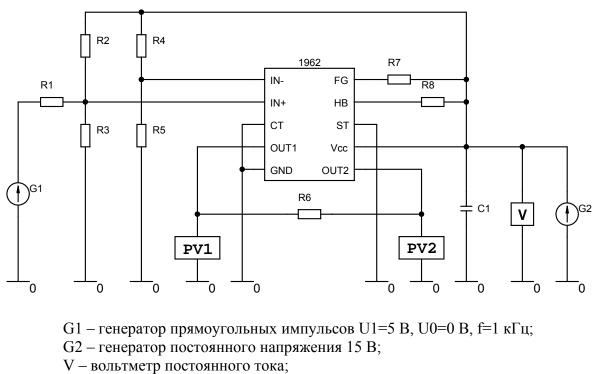


Рис. 10. Схема измерения параметра «Входной ток по выводу ST»



PV1, PV2 – двухлучевой осциллограф

R1, R3, R5 – 2 κ OM \pm 5%;

R2, R4 – 13 кОм ± 5%;

- R6 39 Ом ± 5% 2 Вт;
- $R7 3 \text{ KOm} \pm 5\%;$
- R8 1.5 кОм ± 5%;
- C1-1 мк $\Phi \pm 10\%$

Рис. 11. Схема включения микросхем при испытаниях на безотказность

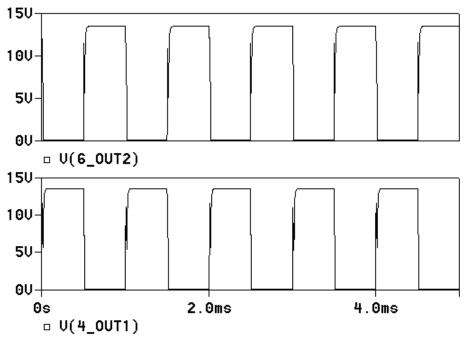


Рис. 12. Форма импульсов напряжений на входах микросхемы

5. Маркировка, упаковка, хранение

5.1. Микросхема в бескорпусном исполнении не маркируется. Обозначение микросхем в бескорпусном исполнении, номер партии, количество годных кристаллов проставляется на этикетке.

5.2. Упаковка микросхем в бескорпусном исполнении (пластин) производится согласно СТП ЮФ20.15.1-02.

5.3. Срок сохраняемости микросхем в бескорпусном исполнении:

a) при хранении в упаковке предприятия-изготовителя в отапливаемом помещении – 12 месяцев;

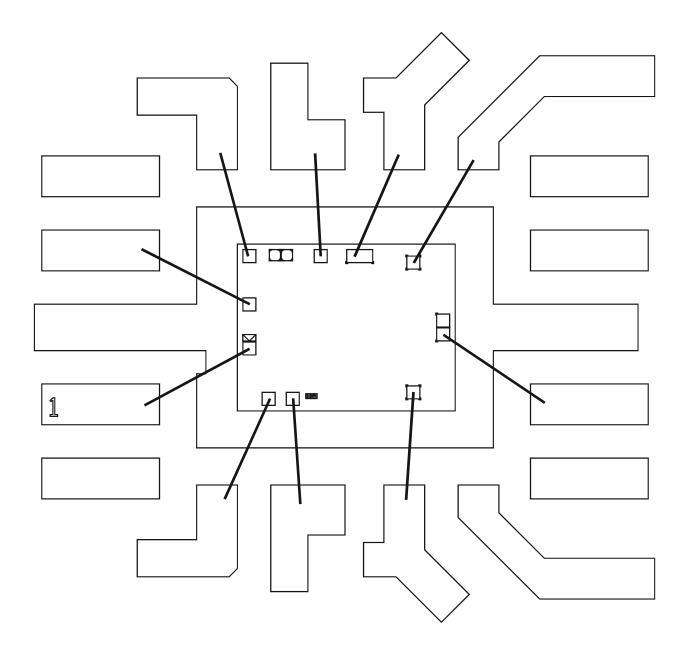
б) после изъятия микросхем в бескорпусном исполнении из упаковки предприятияизготовителя до их сборки в корпус (герметизация) – 10 суток в условиях, соответствующих требованиям для производства микросхем.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Требования к сборке в условный корпус

В качестве условного корпуса используется DIP-16 (2103.16-2). Посадка кристалла на токопроводящий клей ТОК-1. Разварка проводится золотой проволокой диаметр 0.03 мм.

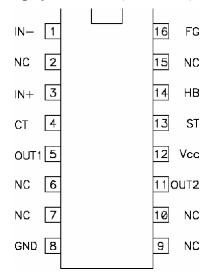
Схема разварки в условный корпус



Номер площадки	Номер вывода	Наименование площадки	Наименование вывода
1	1	IN –	IN –
_	2	_	NC
2	3	IN +	IN +
3	4	СТ	СТ
4	5	OUT1	OUT1
_	6	_	NC
—	7	_	NC
5	8	GND	GND
_	9	_	NC
_	10	_	NC
6	11	OUT2	OUT2
7	12	VCC	VCC
8	13	ST	ST
9	14	HB	HB
_	15	_	NC
10	16	FG	FG

Таблица соответствия выводов корпуса DIP-16 (2103.16-2) контактным площадкам на кристалле

Назначение выводов корпуса DIP-16 (2103.16-2)



ПРИМЕЧАНИЕ:

NC – нет контакта